



161969

REGION TECNICA  
CLASIFICACION IPC  
CLASE H01  
SUBCLASE L

# MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un.....

## MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: FAGOR ELECTROTECNICA S.C.I., de nacionalidad española.

RESIDENCIA: MONDRAGON (Guipuzcoa)

ENUNCIADO: "DIODO DE SILICIO".

Prioridad: Patente n.º del



1

La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre el que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusivo en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, de acuerdo con la vigente Legislación, que como el enunciado indica se trata de "DIODO DE SILICIO".

5

10

El presente invento se relaciona con un diodo de silicio que es apto para su incorporación en circuitos electrónicos, asegurando una calidad uniforme y una gran estabilidad de las características eléctricas tanto en sentido directo como en sentido inverso.

15

20

Según la invención el diodo de silicio se caracteriza esencialmente por el hecho de estar constituido por un cuerpo base a modo de receptáculo de forma cilíndrica abierto por su parte superior, en cuyo fondo es fijado una tableta de silicio a través de una aleación mientras que a la cara opuesta de dicha tableta de silicio se fija uno de los terminales siendo depositado posteriormente una resina que cubre parte de la cavidad cilíndrica del receptáculo que es posteriormente llenado por otra resina de araltid; el otro terminal es unido al cuerpo base a través de un alojamiento de éste.

25

Para comprender mejor la naturaleza del presente invento en el plano adjunto representamos una forma preferente de realización a la que remitimos nuestra descripción con carácter explicativo y no limitativo.

30

La figura 1, es una sección ampliada del alzado del diodo.

La figura 2, es una vista en alzado del diodo.

Las particularidades anotadas son las siguientes:

Nº 1.- Cuerpo base.



1

Nº 2.- Tableta de silicio.

Nº 3.- Aleación.

Nº 4.- Terminal.

Nº 5.- Aleación.

5

Nº 6.- Resina.

Nº 7.- Resina epoxi.

Nº 8.- Terminal.

Nº 9.- Alojamiento.

Nº 10.- Soldadura.

10

Según se observa en la figura, el diodo de silicio consta esencialmente de un cuerpo base (1) a modo de receptáculo de forma cilíndrica abierto por su parte superior y de material preferentemente de cobre plateado o latón.

15

Sobre dicho cuerpo base (1) y en el fondo del mismo se fija una tableta de silicio (2) a través de una aleación (3) que está constituido preferentemente de una mezcla de plomo, plata e iridio.

20

En la cara opuesta de la tableta de silicio (2) se fija un terminal (4) a través de otra aleación (5) de idénticas características que la aleación empleada para la soldadura de la tableta (2) al cuerpo base (1). El terminal (4) es preferentemente de cobre plateado o estañado.

25

Una vez efectuada la soldadura del terminal (4) sobre la tableta de silicio (2) se deposita una resina (6) que cubre parte de la cavidad cilíndrica del cuerpo base (1), siendo llenada dicha cavidad después de una resina epoxi, preferentemente por un procedimiento de colada.

30

A través del alojamiento (9) del cuerpo base (1) se verifica la unión del otro terminal (8) por medio de soldadura (10).



1

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como su realización industrial, sólo cabe añadir que en su conjunto y partes constitutivas es posible introducir cambios de forma, materia y disposición en cuanto tales alteraciones no supongan variación sustancial del mismo.

5

El solicitante al amparo de los Convenios Internacionales sobre Propiedad Industrial, se reserva el derecho de extender esta demanda a los países extranjeros, si fuera posible, reivindicando la misma prioridad de la presente solicitud.

10

#### NOTA

El Modelo de Utilidad que se solicita como nuevo en España, por veinte años, de acuerdo con la vigente Legislación deberá recaer sobre "DIODO DE SILICIO", en todo de acuerdo con las siguientes,

15

#### REIVINDICACIONES:

20

1ª.- Diodo de silicio que esencialmente se caracteriza por el hecho de estar constituido de un cuerpo base a modo de receptáculo de forma cilíndrica abierto por su parte superior en cuyo fondo es fijada una tableta de silicio a través de una aleación mientras que en la cara opuesta de dicha tableta de silicio se fija uno de los terminales con el intermedio de una aleación, siendo posteriormente depositada una resina que cubre parte de la cavidad cilíndrica del receptáculo que es posteriormente llenado por otra resina epoxi; el otro terminal es unido al cuerpo base a través de un alojamiento de éste.

25

2ª.- "DIODO DE SILICIO".

30

Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas por una so-



la cara, acompañada de sus correspondientes dibujos.

1

Madrid, 23 SET. 1970

El Agente Oficial

5

MIGUEL FERNANDEZ - LOAYSA PINZON  
P. P.

Firmado: José Antonio Urizar Anasagasti

10

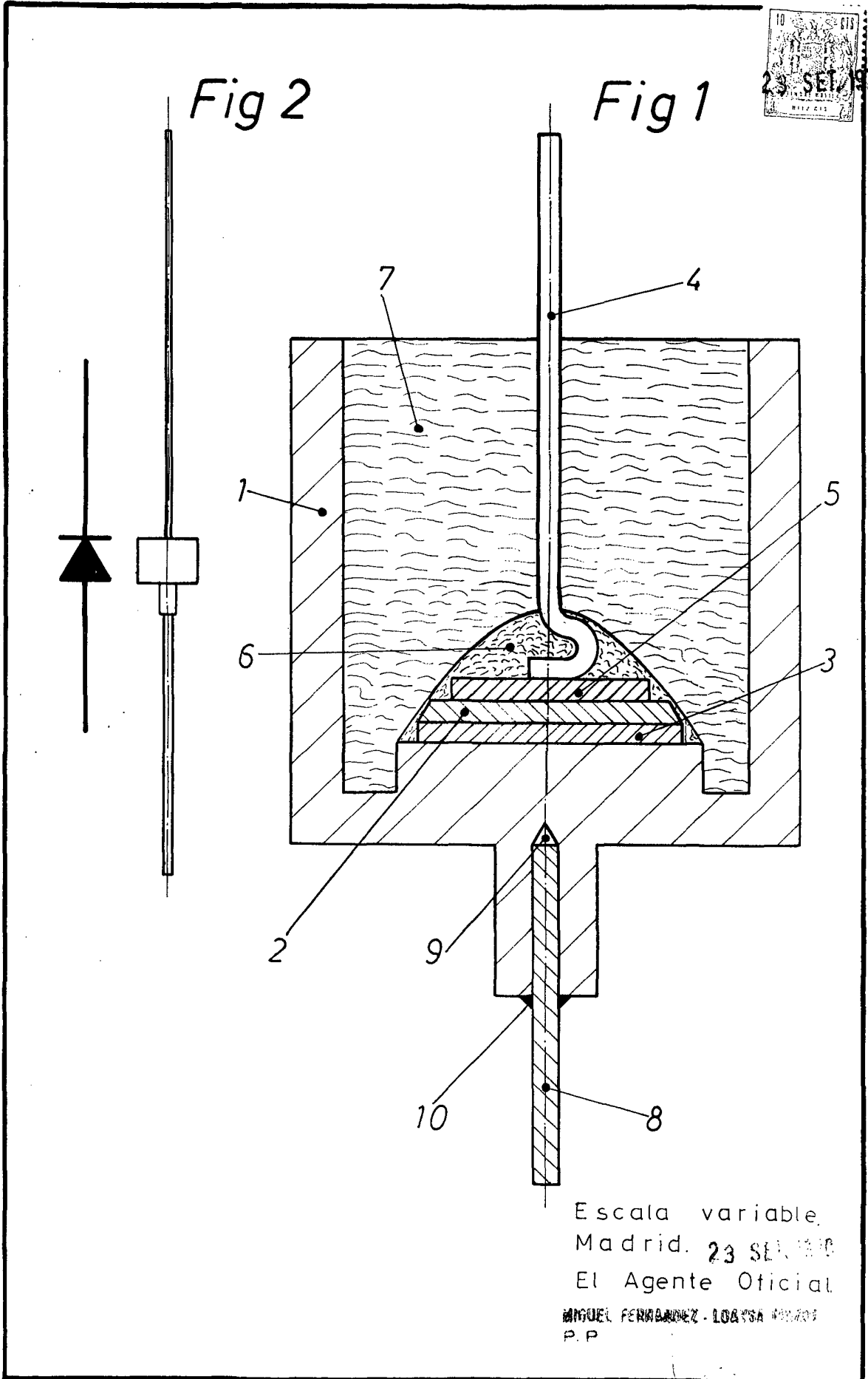
15

20

25

30

10 619  
23 SET 1970  
MEXICO



Escala variable,  
Madrid. 23 SET 1970  
El Agente Oficial  
MIGUEL FERNANDEZ - LOAYSA  
P. P.